

表面處理	介電層	沉積厚度 (nm)	沉積後退火 (PDA)	上電極	金屬沉積後 退火 (PMA)
RTO	HfO ₂	5	1. ×	TaPt	1.×
SC1			2. R600 3. R800		2.R500
<p>Ps.</p> <p>R500 : RTA at 500°C for 30 sec in N₂.</p> <p>R600 : RTA at 600°C for 30 sec in N₂.</p> <p>R800 : RTA at 800°C for 30 sec in N₂.</p>					

表 2-1 實驗條件。

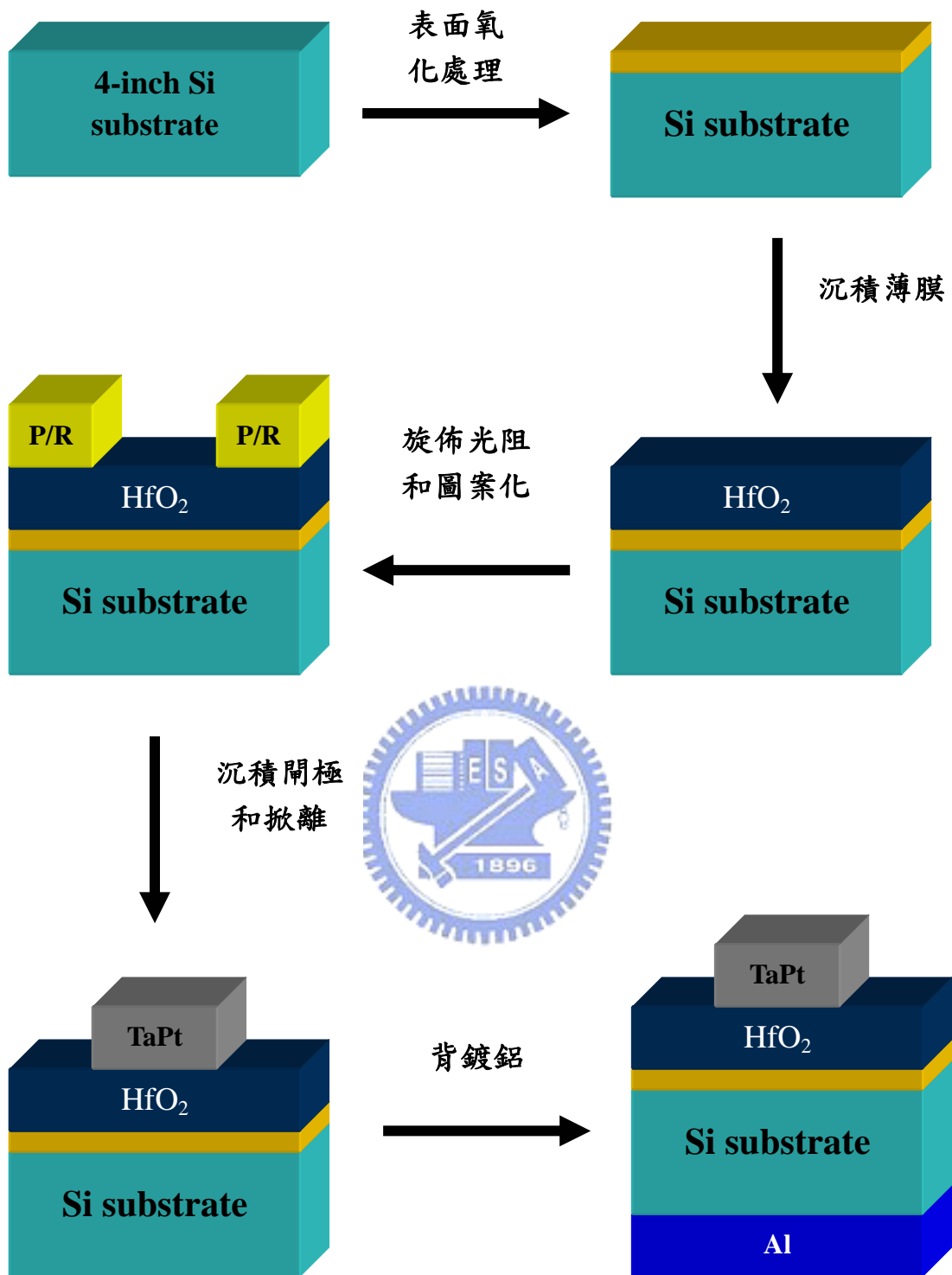


圖 2-1 二氧化鈣電容結構製作流程圖。

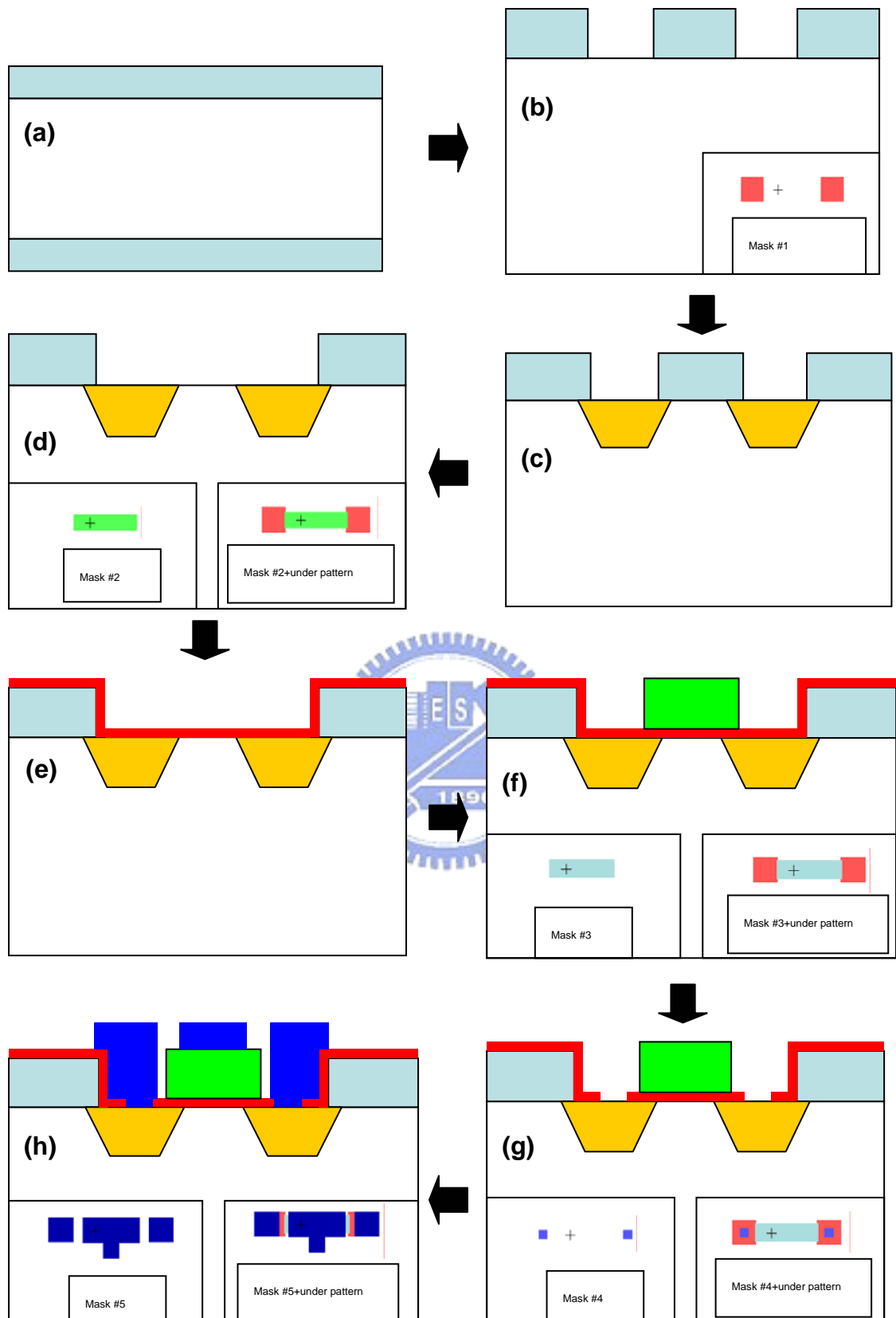


圖 2-2 二氧化矽金屬閘極場效電晶體製作流程圖。